

**11074** LLEI 11/1988, de 3 de maig, de protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors. («BOE» 108, de 5-5-1988.)

JUAN CARLOS I

REI D'ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,  
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

El paper que els productes semiconductors exerceixen en el món té més importància cada dia, no només en el camp de la indústria electrònica mateixa, sinó en tota una àmplia gamma de sectors industrials. El fet que sectors com el de l'automòbil, la telefonia, les comunicacions, el de fabricació d'equips militars, el de màquines recreatives, els programes espacials, etc., depenguin cada vegada més d'aquesta tecnologia, ens porta a acceptar el fet que la nostra vida diària està íntimament lligada al seu desenvolupament.

Les funcions dels productes semiconductors depenen en gran mesura de les seves topografies. L'estructura i disposició dels elements, així com de les diferents capes que componen el circuit integrat, cosa que en definitiva constitueix la seva «topografia», són resultat directe del disseny i representen una part important de l'esforç creatiu, i la seva concepció exigeix considerables recursos humans, tècnics i financers.

Com a conseqüència del procés necessari, el cost del disseny és molt elevat, perquè requereix el disseny del circuit funcional, el de cada element individual del circuit, el de la seva disposició geomètrica i el de les interconnexions. Tanmateix, una vegada realitzat el disseny, el cost de fabricació no és elevat.

Si concebre i dissenyar un circuit integrat és costós i difícil, copiar-lo és, en canvi, relativament fàcil i el seu cost molt inferior al necessari per al seu desenvolupament.

Per això es considera necessari establir, en nom de la innovació tecnològica, la protecció dels creadors de les topografies dels productes semiconductors, de manera que puguin amortitzar les inversions mitjançant la concessió de drets exclusius.

D'altra banda, el Consell de la Comunitat Econòmica Europea, sobre la base de les anteriors consideracions, va adoptar la Directiva 87/54/CEE, de 16 de desembre de 1986, sobre la protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors, a l'article 11 del qual s'estableix que els estats membres han d'adoptar les mesures necessàries per a la seva protecció mitjançant la concessió de drets exclusius.

#### Article 1. Definicions.

Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

1. Producte semiconductor, la forma final o intermèdia de qualsevol producte:

- constituït per un substrat que inclogui una capa de material semiconductor,
- que tingui una o més capes suplementàries de materials conductors, aïllants o semiconductors, disposades en funció d'una estructura tridimensional predeterminada, i
- destinat a desenvolupar, exclusivament o juntament amb altres funcions, una funció electrònica.

2. Topografia d'un producte semiconductor, una sèrie d'imatges interconnectades, sigui quina sigui la manera com estiguin fixades o codificades:

- que representin l'estructura tridimensional de les capes que componen el producte semiconductor,
- en la qual cada imatge tingui l'estructura o part de l'estructura d'una de les superfícies del producte semiconductor en qualsevol de les seves fases de fabricació.

3. L'explotació comercial, la venda, el lloguer, l'arrendament financer o qualsevol altre mètode de distribució comercial, o una oferta amb aquestes finalitats.

Als efectes de la definició anterior, no s'hi inclou l'explotació que es realitzi en condicions de confidencialitat, sempre que no es produeixi distribució a tercers. No obstant això, sí que s'hi inclou l'explotació que es realitzi en condicions de confidencialitat quan aquestes estiguin exigides per raons de seguretat en relació amb aplicacions militars.

#### Article 2. Requisits de protecció.

1. S'han de protegir les topografies dels productes semiconductors mitjançant la concessió de drets exclusius, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.

2. La topografia d'un producte semiconductor ha de ser objecte de protecció en la mesura que sigui el resultat de l'esforç intel·lectual del seu creador i no sigui un producte corrent en la indústria de semiconductors. Si la topografia d'un producte semiconductor està constituïda per elements corrents en la indústria de semiconductors, està protegida només en la mesura que la combinació d'aquests elements, com a conjunt, compleixi els requisits esmentats.

#### Article 3. Dret a la protecció.

1. El dret a la protecció pertany a les persones que siguin creadores de les topografies de productes semiconductors, sense perjudici del que disposen els apartats següents:

2. a) El dret a la protecció de les topografies de productes semiconductors, creades pel treballador durant la vigència del seu contracte o relació de treball amb l'empresa, es regeix pel que estableix el títol IV, Invencions laborals, de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

b) El dret a la protecció de les topografies de productes semiconductors, creades en virtut d'un contracte no laboral, correspon a la part contractual que hagi encarregat la topografia, llevat que el contracte estipuli el contrari.

3. a) Es beneficien de la protecció d'aquesta Llei:

Les persones naturals esmentades als paràgrafs 1 i 2 que tinguin la nacionalitat d'un Estat membre de la Comunitat Europea o que resideixin habitualment en el territori d'un Estat membre, així com les persones jurídiques esmentades al paràgraf 2 que tinguin un establiment industrial o comercial real i efectiu en el territori d'un Estat membre de la comunitat econòmica europea.

b) També es beneficien de la protecció d'aquesta Llei les persones naturals o jurídiques que responguin a les condicions establertes a l'apartat a) del paràgraf 3 d'aquest article, que siguin les primeres a explotar comercialment en un Estat membre una topografia que encara no hagi estat explotada comercialment a cap altre lloc i que hagin rebut, de la persona amb dret a disposar de la topografia, l'autorització per explotar-la comercialment de manera exclusiva a tota la Comunitat.

4. El dret a la protecció també s'aplica a favor dels drethavents de les persones esmentades als paràgrafs anteriors.

#### Article 4. Registre.

1. Perquè la topografia d'un producte semiconductor es beneficiï dels drets exclusius, concedits d'acord amb l'article 2, s'ha de presentar una sol·licitud de registre davant el Registre de la propietat industrial. S'ha d'establir per reglament la forma i les condicions de la sol·licitud de registre, de la tramitació i resolució d'aquesta, i també de la publicació de l'acord de Registre, si s'escau.

La sol·licitud de registre també es pot presentar a les direccions provincials del Ministeri d'Indústria i Energia, llevat que la competència per a l'execució en matèria de propietat industrial correspongui a la comunitat autònoma, els òrgans de la qual són, en aquest cas, els competents per rebre la documentació. En aquests casos, la unitat administrativa que hagi rebut la sol·licitud ha de fer constar, mitjançant una diligència, el dia, l'hora i el minut de la presentació i l'han de remetre al Registre de la propietat industrial.

Tant la sol·licitud de Registre com els altres documents que s'hagin de presentar en el Registre de la propietat industrial han d'estar redactats en castellà. A les comunitats autònomes on també hi hagi una altra llengua oficial, aquests documents es poden redactar en la llengua esmentada, i s'hi ha d'adjuntar la corresponent traducció al castellà, que es considera autèntica en cas de dubtes entre totes dues.

Aquesta sol·licitud es pot presentar abans de començar l'explotació comercial o en un termini màxim de dos anys, comptats a partir de la data del començament de l'explotació. Amb la sol·licitud de registre s'ha de dipositar el material que identifiqüi o que representi la topografia, o una combinació dels esmentats elements, així com una declaració en un document públic referent a la data de la primera explotació comercial de la topografia, quan la data sigui anterior a la de sol·licitud de registre.

2. El material dipositat d'acord amb l'apartat anterior no és accessible al públic si constitueix un secret comercial. Tanmateix, això no afecta la revelació de l'esmentat material com a conseqüència d'una resolució judicial o d'altres autoritats competents que siguin part d'un litigi respecte a la validesa o violació dels drets exclusius esmentats a l'article 2.

3. Qualsevol transferència de drets exclusius sobre les topografies de productes semiconductors només produeix efectes davant tercers de bona fe, si ha estat inscrita en el Registre de la propietat industrial.

4. Les persones amb dret a la protecció de les topografies de productes semiconductors, en virtut del que preveu aquesta Llei, que puguin demostrar que un tercer ha sol·licitat i obtingut el registre d'una topografia sense autorització poden reivindicar davant els tribunals la titularitat de la topografia, sense perjudici de qualssevol altres drets o accions que li puguin correspondre. L'acció reivindicatòria només es pot exercir en un termini de dos anys, comptats des de la data de publicació del registre de la topografia del producte semiconductor.

#### Article 5. Contingut dels drets exclusius.

1. Els drets exclusius que preveu l'article 2 inclouen els d'autoritzar o prohibir els actes següents:

a) la reproducció d'una topografia en la mesura que estigui protegida en virtut del paràgraf 2 de l'article 2, llevat de la reproducció a títol privat amb fins no comercials;

b) l'explotació comercial o la importació amb aquesta finalitat d'una topografia o d'un producte semiconductor en la fabricació del qual s'hagi utilitzat la topografia.

2. Els drets exclusius previstos al paràgraf 1 no s'apliquen a les reproduccions amb fins d'anàlisi, avaluació o ensenyament dels conceptes, procediments, sistemes o tècniques incorporats a la topografia o de la mateixa topografia.

3. Els drets exclusius que preveu el paràgraf 1 no s'estenen als actes relatius a una topografia que compleixi els requisits de l'apartat 2 de l'article 2 i en què la creació estigui basada en l'anàlisi i l'avaluació d'una altra topografia efectuades d'acord amb l'apartat 2 del present article.

4. Els drets exclusius d'autorització o prohibició dels actes esmentats a l'apartat b) del paràgraf 1 del present article no són aplicables als actes realitzats a Espanya en relació amb les topografies o productes semiconductors que hagin estat comercialitzats en un Estat membre de la Comunitat Econòmica Europea pel titular dels drets exclusius o amb el seu consentiment.

5. No es pot impedir a una persona l'explotació comercial d'un producte semiconductor, sempre que en el moment d'adquirir el producte no sàpiga o no tingui motius fonamentats per pensar que aquest està protegit per un dret exclusiu, concedit d'acord amb el que preveu aquesta Llei.

No obstant això, pel que fa als actes realitzats després que la persona sàpiga o tingui motius fonamentats per pensar que el producte semiconductor està emparat per aquesta protecció, el titular del dret pot exigir davant els tribunals el pagament d'una remuneració adequada.

6. El que disposa l'apartat anterior s'aplica també als drethavents de la persona esmentada al primer incís de l'esmentat paràgraf.

#### Article 6. Llicències obligatòries.

Els drets exclusius que preveu l'article 2 poden ser sotmesos a llicències obligatòries quan hi hagi motius d'interès públic que ho aconsellin. A aquests efectes, són aplicables els articles 90, 100, 101 i 102 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

#### Article 7. Durada de la protecció.

1. Els drets exclusius que preveu l'article 2 neixen a la primera en el temps de les dates següents:

a) En la que la topografia ha estat objecte d'explotació comercial per primera vegada a qualsevol lloc del món.

b) En la que s'hagi presentat la sol·licitud de registre en la forma escaient.

2. Els drets exclusius expiren transcorreguts deu anys, comptats a partir de la primera en el temps de les dates següents:

a) Al final de l'any en què la topografia ha estat objecte d'explotació comercial per primera vegada a qualsevol lloc del món.

b) Al final de l'any en què s'hagi presentat la sol·licitud de registre en la forma escaient.

No obstant això, queda sense efecte qualsevol registre relatiu a una topografia que no hagi estat objecte d'explotació comercial en cap lloc del món en el termini de quinze anys, comptats a partir de la data de la primera fixació o codificació.

#### Article 8. Accions per violació dels drets exclusius.

1. El titular d'una topografia en virtut d'aquesta Llei pot exercir davant els òrgans de la jurisdicció ordinària les accions civils i les mesures previstes al títol VII de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

2. La persona que, tenint dret a la protecció en virtut de l'article 3, pugui provar que un tercer fraudulentament ha reproduït o explotat comercialment o importat amb aquesta finalitat una topografia creada per ella, en el període comprès entre la primera fixació o codificació i el naixement dels drets exclusius de conformitat amb l'apartat 1 de l'article 7, pot exercir davant els tribunals la corresponent acció per competència deslleial.

*Article 9. Extensió de la protecció.*

La protecció concedida a les topografies de productes semiconductors, que preveu l'article 2, només s'aplica a la topografia pròpiament dita amb exclusió de qualsevol altre concepte, procediment, sistema, tècnica o informació codificada incorporats en aquesta topografia.

*Article 10. Signe indicatiu de protecció.*

Els productes semiconductors manufacturats sobre la base de topografies protegides, d'acord amb el que preveu aquesta Llei, poden portar de manera visible i per informar de l'existència d'aquesta protecció una indicació consistent en una T majúscula tancada dins d'un cercle.

*Article 11. Manteniment d'altres disposicions legislatives.*

Les disposicions d'aquesta Llei són aplicables sense perjudici dels drets que reconeixen les vigents disposicions legislatives sobre patents i models d'utilitat.

#### DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.—Es crea la taxa per serveis prestats pel Registre de la propietat industrial en matèria de protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors a la qual són aplicables les regles següents:

1. Normes reguladores.

La taxa es regeix pel que estableix aquesta Llei i, si no, per la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària; per la Llei de taxes i exaccions parafiscals, de 26 de desembre de 1958, i per la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom Registre de la propietat industrial.

2. Fet imposable. La taxa grava:

- a) La sol·licitud de registre de les topografies dels productes semiconductors.
- b) El dipòsit del material que identifiqui o que representi la topografia o una combinació d'aquests elements.
- c) La inscripció de transferències de drets exclusius sobre les topografies de productes semiconductors.

3. Subjectes passius. Són subjectes passius del pagament de la taxa els sol·licitants del registre de topografies, o del dipòsit del material o de la inscripció de transferències.

4. Quotes. La taxa s'exigeix d'acord amb la tarifa següent:

- 1. Taxa per sol·licitud de registre: 6.050 pessetes.
- 2. Taxa per dipòsit de material: 4.000 pessetes.
- 3. Taxa per inscripció de transferències. Per cada registre: 1.200 pessetes.
- 5. Meritació. L'obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar el registre o la inscripció de la transferència o de realitzar el dipòsit del material.
- 6. Afectació. La taxa queda afectada al Registre de la propietat industrial, i s'ha d'integrar en el seu pressupost d'ingressos l'import que s'obtingui de la seva recaptació.
- 7. Gestió. Sota la direcció i control del Ministeri d'Economia i Hisenda, la gestió de la taxa és a càrrec del Registre de la propietat industrial, i queda autoritzada l'autoliquidació d'aquesta taxa.
- 8. Modificació. Les lleis de pressupostos generals de l'Estat poden modificar les quotes establertes a la tarifa per adaptar-les a la variació que experimenti el cost dels serveis que retribueix o la conjuntura economicosocial.

Segona.—La Llei de procediment administratiu s'aplica supletòriament als actes administratius regulats en aquesta Llei, que poden ser recorreguts en l'ordre contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la seva Llei de jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de desembre de 1956.

#### DISPOSICIONS FINALS

Primera.—S'autoritza el Govern a dictar les mesures i disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'aplicació del que disposa aquesta Llei.

Segona.—S'autoritza el Govern per modificar les definicions dels punts a) i b) del paràgraf 1 de l'article 1, quan aquestes siguin revisades pels òrgans de les Comunitats Europees, amb la finalitat d'adaptar les definicions al progrés tècnic.

Tercera.—S'autoritza el Govern per modificar l'article 3.3, amb la finalitat d'ampliar el dret a la protecció a persones originàries de tercers països o territoris, que no es beneficiïn de la protecció quan així ho estableixin els òrgans de les Comunitats Europees.

Així mateix, el Govern pot ampliar la protecció a persones que no estiguin incloses a l'apartat anterior, mitjançant la subscripció del corresponent acord amb l'Estat del qual siguin originàries, seguint el procediment que preveu l'article 3, apartats 6 a 8, de la Directiva 87/54/CEE, de 16 de desembre de 1986.

Quarta.—Aquesta Llei entra en vigor al cap de quatre mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat.»

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 3 de maig de 1988.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,  
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ